บทที่ 4 อันตรกิริยาของไมโครเวฟกับวัสดุไดอิเลคตริก

สำหรับบทนี้ได้ทำการขยายเนื้อหาจากที่เคยกล่าวไว้ในบทที่ 2 โดยในที่นี้จะทำการ วิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างกลื่นไมโครเวฟและวัสดุไดอิเลกตริก

เป็นที่ทราบกันดีว่าการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในวัสดุไดอิเลคตริกหรือโหลด (เช่น อาหาร) ที่ได้รับความร้อนจากกลื่นไมโครเวฟ จะถูกกำหนดโดยคุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร และการกระจายตัวของการดูดซับพลังงานไมโครเวฟ (Microwave Absorption) ภายในอาหาร นั่นเอง ปริมาณของการดูดซับพลังงานไมโครเวฟนี้ก็ถูกกำหนดโดยสนามไฟฟ้าภายในระบบการทำ ความร้อนด้วยไมโครเวฟ เช่นในตู้ไมโครเวฟหรือ แอพพลิเคเตอร์ (Applicator) สำหรับบทนี้จะ สนใจที่ธรรมชาติของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในตู้ไมโครเวฟหรือ แอพพลิเคเตอร์ และแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายโดยผ่านสมการแม็กซ์เวลล์ องค์ความรู้พื้นฐานจากบทนี้จะนำไปสู่การ วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ ในบทถัดๆไป

4.1 หลักการพื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เมื่อเราให้ความต่างศักย์ไฟฟ้า V ที่ความถี่ ω เท่ากับ 2πf แก่แผ่นคู่ขนาน (Parallel Plate) ดังรูปที่ 2 จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าในระหว่างแผ่นคู่ขนาน หากทำการวางวัสดุไดอิเลกตริก เช่น อาหาร ไว้ระหว่างแผ่นคู่ขนาน จะมีการเปลี่ยนขนาดของสนามไฟฟ้าทั้งภายในวัสดุและในช่องว่าง อากาศที่ด้านข้างทั้งสองของวัสดุ ปริมาณของพลังงานสะสมในระบบก็จะเปลี่ยนไป ภายในอาหาร ก็จะมีการกระจายตัวของพลังงานบางส่วน (Dissipation of Energy) เหมือนกับที่เกิดขึ้นภายในวัสดุ ใดอิเลกตริก เช่น อาหารเมื่อได้รับพลังงานไมโครเวฟ ก็จะมีการการกระจายตัวของพลังงาน บางส่วน โดยทั่วไปเราเรียกวัสดุประเภทนี้ว่า วัสดุสูญเสีย หรือวัสดุลอสซี่ (Lossy Material) เพราะ พลังงานไมโครเวฟที่หายไปจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนภายในวัสดุนั่นเอง [1]



รูปที่ 4.1 แอพลิเคเตอร์แบบแผ่นคู่ขนาน (Parallel Plate Applicator)

จากนี้เป็นต้นไปเราจะทำการอธิบายถึงกลไกของอันตรกิริยาระหว่างสนามไฟฟ้ากับวัสดุ ใดอิเลคตริก ซึ่งองค์ความรู้จากบทนี้จะสัมพันธ์กับการศึกษาสมบัติไดอิเลคตริก (Dielectric Properties) ซึ่งจะถูกนำเสนอภายหลังในบทที่ 5 แต่สำหรับบทนี้เราจะเริ่มต้นกับสมมติง่ายๆเกี่ยวกับ อันตรกิริยาโดยค่าคอมเพล็กซ์เปอร์มิตติวิตี้ (Complex Permittivity; ε) และค่า เปอร์มีลิตี้ (Permeability; μ) ที่บ่งบอกถึงการกักเก็บและการลดลงของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็ก ตามลำคับ [2]

้โดยค่าคอมเพล็กซ์เปอร์มิตติวิตี้แสดงความสัมพันธ์ได้ดังสมการต่อไปนี้

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r = \varepsilon_0 \left(\varepsilon_r' - j \varepsilon_r'' \right) \tag{4.1}$$

โดยที่

$$j = \sqrt{-1}$$

- ɛˈ, ค่าคงที่ใดอิเลคตริกสัมพัทธ์ (Relative Dielectric Constant) หรือค่าเปอร์ มิตติวิตี้สัมพัทธ์ (Relative Permittivity)
- $\varepsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} F / m$ คือค่าเปอร์มิตติวิตี้ของฟรีสเปซหรืออากาศ (Permittivity of Free Space)
- $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N / m^2$ ค่าเปอร์มีลิตี้ (Permeability) ซึ่งมักกำหนดให้เท่ากับ ค่าของของฟรีสเปซหรืออากาศ

4.1.1 ระบบแบบแผ่นคู่ขนาน

ถ้าแหล่งกำเนิดความต่างศักย์ถูกเชื่อมกับคู่ของแผ่นขนาน แอพพลิเคเตอร์แบบแผ่นคู่ขนาน อย่างง่ายๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นดังรูปที่ 2 ในที่นี้จะไม่คำนึงถึงอิทธิพลของขอบที่มีผลต่อสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าเราสามารถประมาณค่าสนามไฟฟ้าและความหนาแน่นสนามไฟฟ้าภายในวัสดุไดอิเลคตริก ระหว่างแผ่นคู่ขนานได้ดังนี้ [3]

$$\hat{E} = \frac{\hat{V}}{d_{mat} + 2d_{air}(\varepsilon_{mat}/\varepsilon_0)} \qquad \text{V/m}$$
(4.2)

สนามไฟฟ้านี้ก็จะเป็นสาเหตุของการไหลของกระแสเข้าไปยังวัสดุด้วยความหนาแน่นของกระแส (Current Density) เท่ากับ

$$\hat{J} = j\omega\varepsilon\hat{E} \qquad \qquad A/m^2 \qquad (4.3)$$

เมื่อความหนาแน่นกำลัง (Power Density) หรือกำลังการดูคซับ (Power Absorbed) ภายในวัสดุ [3] คือ

$$Q = \frac{1}{2}\omega\varepsilon_0\varepsilon_{eff} \left| \hat{E} \right|^2 \qquad W/m^3 \qquad (4.4)$$

โดยที่

 \hat{E} ก่าสูงสุดของสนามไฟฟ้า

เห็นได้อย่างชัดเจนจากสมการที่ (4.2) และ (4.4) ว่าค่า เปอร์มิตติวิตี้มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ต่อสนามไฟฟ้าและกำลังไมโครเวฟที่ลดลงในวัสดุ พลังงานที่หายไป *Q* เป็นแหล่งกำเนิดของ กระบวนการทำความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ ที่จะนำไปสู่การถ่ายเทความร้อนและความชื้น

4.2 สมการแม็กซ์เวลล์ (Maxwell's Equations)

ระบบการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ เช่นในตู้ไมโครเวฟหรือ แอพพลิเคเตอร์ ที่ทำงาน จริงนั้นจะมีความซับซ้อนกว่าระบบแผ่นคู่ขนานที่อธิบายกันในหัวข้อที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก การ อธิบายที่สมบูรณ์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมทางกายภาพอย่างถ่องแท้ โดย ปกติการอธิบายพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะกระทำโดยผ่านสมการแม็กเวลล์ (Maxwell's Equations) ซึ่งสามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ตามเวลา เมื่อใส่เงื่อนไขขอบเขตที่สมบูรณ์ลงไปก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าภายในตู้ไมโครเวฟหรือ แอพพลิเคเตอร์ ได้อย่างสมบูรณ์

สมการแรกของสมการแม็กซ์เวลล์ คือ กฎของฟาราเคย์ (Faraday's Law) ที่โยง ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้า E ที่เปลี่ยนไปกับเวลา กับสนามแม่เหล็ก H หรือกล่าวได้ว่า สนามไฟฟ้าที่หมุนวนรอบๆคอนทัวร์ เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์สนามแม่เหล็กที่ผ่าน พื้นที่ผิวที่ล้อมรอบด้วยคอนทัวร์ ซึ่งแสดงได้ด้วยรูปสมการอนุพันธ์ในลักษณะไทม์ฮาโมนิค ดังต่อไปนี้

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{4.5}$$

สมการที่สองของสมการแม็กซ์เวลล์ คือ กฎของแอมแปร์ ที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างค่า ความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Strength) *H* กับความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ารวม (Total Current Density) *J*, (ซึ่งรวมผลของกระแสดิสเพลสเมนต์และกระแสเหนี่ยวนำ) หรือกล่าวได้ว่า ความเข้มสนามแม่เหล็กที่หมุนวนรอบๆคอนทัวร์ผิวปิด (Closed Contour) เท่ากับกระแสสุทธิที่ผ่าน พื้นที่ผิวที่ล้อมรอบด้วยคอนทัวร์ ยกตัวอย่างเช่น สนามไฟฟ้าที่ล้อมรอบ (Surrounded) โดย สนามแม่เหล็กเป็นต้น ซึ่งแสดงได้ด้วยรูปสมการอนุพันธ์ในลักษณะไทม์ฮาโมนิค (Time Harmonic) ดังต่อไปนี้

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial D}{\partial t} \tag{4.6}$$

เพื่อความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ (Gauss's Law) ถูกนำมาใช้ กล่าวคือฟลักซ์แม่เหล็กสุทธิที่ออกจากขอบเขตเท่ากับศูนย์และฟลักซ์ไฟฟ้าสุทธิ ที่ออกจากขอบเขตจะสัมพันธ์กับความหนาแน่นประจุ (Charge) ภายในวัสคุนั้น จะได้

$$\nabla \cdot \vec{D} = q \tag{4.7}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{4.8}$$

โดยที่

q คือความหนาแน่นประจุไฟฟ้า (Charge Density)
 เมื่อ E และ H คือความเข้มของสนามไฟฟ้าและความเข้มของสนามแม่เหล็ก
 ตามลำคับ J คือความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (Current Density) D คือความ

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \tag{4.9}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \tag{4.10}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \tag{4.11}$$

โดยที่

σ คือ ค่าการนำไฟฟ้า (Electric Conductivity

- μ คือค่าเปอร์มีสิตี้ (Permeability)
- arepsilon คือค่าคงที่ไดอิเลคตริก (Dielectric Constant) หรือค่าเปอร์มิตติวิตี้

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ประจุและ กระแส มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งอาจเขียนให้อยู่ในรูปแบบสมบูรณ์ของสมการ อนุพันธ์ (สมการแม็กซ์เวลล์) รูปแบบสมการอนุพันธ์ของสมการแม็กซ์เวลล์ เป็นที่นิยมใช้กันอย่าง กว้างขวาง ในการแก้ปัญหาเพื่อจะหาคำตอบที่เงื่อนไขค่าของขอบเขตต่างๆ ซึ่งรูปแบบคังกล่าว สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า สนามไฟฟ้า *E* และค่าความเข้มของ สนามแม่เหล็ก *H* โดยการแทนสมการที่ (4.9) ถึง (4.11) ลงในสมการที่ (4.5) ถึง (4.8) จะได้คือ

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$
(4.12)

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
(4.13)

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{q}{\varepsilon} \tag{4.14}$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0 \tag{4.15}$$

สมการที่ (4.12) และ (4.13) อ้างอิงมาจาก กฎของกฎของฟาราเคย์ สมการที่ (4.5) และกฎ แอมแปร์ และกฎของฟาราเคย์ สมการที่ (4.6) ตามลำคับ ส่วนสมการที่ (4.14) และ (4.15) จะขึ้นอยู่ กับกฎของเกาส์ สมการที่ (4.7) และ (4.8) ตามลำคับ

ต่อไปนี้เราจะทำการพิสูจน์ที่มาของสมการค่ากำลังการดูดซับภายในวัสดุไดอิเลคตริกขณะ เกิดอันตรกิริยาระหว่างคลื่นไมโครเวฟกับวัสดุไดอิเลคตริก ดังนี้

อ้างถึงชุดสมการแม็กซ์เวลล์ สมการที่ (4.12) ถึงสมการที่ (4.15) ทำการคูณเชิงสเกลาร์ใน สมการที่ (4.13) ด้วย E และสมการที่ (12) ด้วย H เราสามารถเขียนสมการแม็กซ์เวลล์ ใหม่ใน รูปของพลังงาน คือ

$$\vec{E}.(\nabla \times \vec{H}) = \vec{E}.\left(\sigma \vec{E} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$$
(4.16)

$$\vec{H}.\left(\nabla \times \vec{E}\right) = -\vec{H}.\left(\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right)$$
(4.17)

ทำการหักลบสมการที่ (17) ด้วยสมการที่ (16) และใช้คุณสมบัติของความสัมพันธ์ระหว่าง สอง เวกเตอร์ ในที่นี้คือ เวกเตอร์ F₁และ F₂ และเขียนในรูปความสัมพันธ์ก็จะได้

$$\nabla \cdot \left(\vec{F}_1 \times \vec{F}_2\right) = \vec{F}_2 \cdot \left(\nabla \times \vec{F}_1\right) - \vec{F}_1 \cdot \left(\nabla \times \vec{F}_2\right)$$
(4.18)

จากคุณสมบัติของสมการที่ (4.18) เราสามารถจัครูปความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปสมการการ อนุรักษ์พลังงานคือ

$$\nabla \left(\vec{E} \times \vec{H} \right) + \vec{H} \cdot \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \left(\sigma \vec{E} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0$$
(4.19)

เมื่อทำการอินทิกรัลตลอดปริมาตรของโดเมนและประยุกต์ใช้ทฤษฎีใดเวอร์เจนส์ (Divergence theorem) ซึ่งโยงความสัมพันธ์กันระหว่างการหาอินทิกรัลเชิงพื้นผิว (Surface Integral) กับอินทิกรัลเชิงปริมาตร (Volume Integral) ก็จะได้เป็น

$$\iint (E \times H) ds + \iiint \left[\vec{H} \cdot \mu \frac{\partial H}{\partial t} + \vec{E} \cdot \left(\sigma \vec{E} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \right] dV = 0 \qquad (4.20)$$

ในที่นี้เทอมผลดูณ (Cross Product) คือ $E \times H$ แสดงถึงความหนาแน่นกำลังเชิงพื้นผิว (Surface Power Density) ซึ่งมีหน่วยเป็น W/m² ซึ่งเกี่ยวข้องกับทิศทางการ ไหลของกำลัง ซึ่งเรา มักจะอ้างถึงพอยน์ติ้งเวกเตอร์ (Pointing Vector) นั่นเอง หากทำการอินทิกรัลในเทอมที่สองซึ่งเป็น กำลังความหนาแน่นของแม่เหล็ก (Magnetic Power Density) ก็จะได้

$$\vec{H}.\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t} = \frac{1}{2}\mu\frac{\partial\vec{H}^2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\mu\vec{H}^2\right)$$
(4.21)

เช่นเดียวกับขั้นตอนการหาสมการความสัมพันธ์ในรูปกำลังความหนาแน่นของแม่เหล็ก จากสมการที่ (4.20) เราสามารถหาสมการความสัมพันธ์ในรูปกำลังความหนาแน่นของไฟฟ้า (Electric Power Density) ก็จะได้

$$E \cdot \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial \vec{E}^2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon \vec{E}^2 \right)$$
(4.22)

จากสมการข้างบนนี้ เราสามารถลดรูปให้อยู่ในเทอมของค่ากำลังการดูดซับไมโครเวฟ (Microwave Power Absorbed) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค่าของการกำเนิดปริมาณความร้อนภายใน ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร (Local Volumetric Heat Generation) คือ

$$Q = \vec{E} \cdot \left(\sigma \vec{E}\right) = \sigma \left|\vec{E}\right|^2 \tag{4.23}$$

จากสมการที่ (4.23) พบว่าการเปลี่ยนแปลงเฟสของสนามไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยเวลาจะเร็วมาก ดังนั้น ค่าเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square Value) ของความเข้มของสนามไฟฟ้าจะถูกใช้ในการ ประมาณค่าพลังงานไมโครเวฟที่ถูกดูดซับโดยวัสดุไดอิเลกตริก เมื่อสมมติให้ไม่มีการสูญเสีย สนามแม่เหล็ก ค่ากำลังการดูดซับไมโครเวฟหรือ ค่าของการกำเนิดปริมาณความร้อนภายในต่อ หนึ่งหน่วยปริมาตร อาจเขียนให้อยู่ในรูปสมการต่อไปนี้ก็ได้

$$Q = \omega \varepsilon_0 \varepsilon_r'' E^2 = 2\pi \cdot f \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r' (\tan \delta) E^2$$
(4.24)

จากสมการด้านบน ค่าพลังงานไมโครเวฟที่ถูกดูดซับจะแปรผันตรงกับความถี่ของ สนามไฟฟ้า ค่าไดอิเลคตริกลอสแฟกเตอร์ (Dielectric Loss Factor) และค่ากำลังสองของ สนามไฟฟ้า หากค่าไดอิเลกตริกลอสแฟกเตอร์ของวัสดุไดอิเลกตริกมีก่ามากจะส่งผลให้การดูดซับ พลังงานจากไมโครเวฟและปริมาณความร้อนเกิดขึ้นมากขึ้นตาม แต่ถ้าค่าไดอิเลกตริกลอสแฟก เตอร์มีค่าน้อย คลื่นไมโกรเวฟจะทะลุผ่านวัสดุไดอิเลกตริกโดยเกิดความร้อนเพียงเล็กน้อยหรือไม่ เกิดขึ้นเลย อย่างไรก็ตามปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นนี้อาจจะขึ้นกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ค่าความจุ กวามร้อนจำเพาะ (Specific Heat) คุณลักษณะของวัสดุไดอิเลกตริกและขนาดของวัสดุไดอิเลกตริก สมการที่ (4.24) มีความสำคัญในการศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานจากกลื่นไมโครเวฟ ของวัสดุไดอิเลกตริกเมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้าที่ความถี่สูง อย่างไรก็ตามอันตรกิริยาระหว่าง สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและวัสดุไดอิเลกตริกก็ส่งผลต่อคุณสมบัติไดอิเลกตริกของวัสดุนั้นด้วย หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งกือกุณสมบัติไดอิเลกตริกที่ส่งผลต่อกุณสมบัติไดอิเลกตริกของวัสดุนั้นด้วย หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งกือกุณสมบัติไดอิเลกตริกของวัสดุขึ้นอยู่กับการนำไมโกรเวฟไปประยุกต์ใช้งานใน กระบวนการต่างๆ เช่น การทำความร้อน (Heating) การอบแห้ง (Drying) หรือการหลอมละลาย (Melting) เป็นต้น ซึ่งจะได้แสดงในบทถัดๆไป

4.2.1 สมการแม็กซ์เวลล์ ในรูปแบบอย่างง่าย (Simple Maxwell's Equations)

เราสามารถที่จะจัดสมการแม็กซ์เวลล์ จากที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้านี้ให้อยู่ในรูปแบบ ง่ายๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับบางกรณี โดยมีรายละเอียดของการทำ ดังต่อไปนี้

สมการแม็กซ์เวลล์ เป็นสมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ซึ่งมีเงื่อนไขขอบเขตและสามารถ ปรับปรุงให้ไปใช้กับสมการของคลื่นที่อยู่ในรูปสมการอนุพันธ์อันดับสอง ซึ่งก็จะใช้กฎของ แอมแปร์และ ฟาราเดย์เหมือนเดิม ซึ่งเขียนให้อยู่ในรูปสมการดังต่อไปนี้

$$\nabla \times \nabla \times \vec{F} = \nabla \left(\nabla \cdot \vec{F} \right) - \nabla^2 \vec{F}$$
(4.25)

เมื่อกำหนดให้

$$\nabla^{2}\vec{E} - \mu\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon\frac{\partial\vec{E}^{2}}{\partial t^{2}} = 0$$
(4.26)

$$\nabla^{2} \vec{H} - \mu \sigma_{e} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial \vec{H}^{2}}{\partial t^{2}} = 0$$
(4.27)

สมการที่ (4.26) และสมการที่ (4.27) จึงเป็นสมการของคลื่นที่อยู่ในรูปสมการอนุพันธ์อันดับสอง ที่ มีความสัมพันธ์กับเวลา หากพิจารณาในบริเวณส่วนกลางของสเปซหรือช่องว่าง (σ=0) เมื่อเวลาลง ค่าของการกระจายตัวความเร็วจะมีค่าเป็น √με สนามที่ได้จากการใช้สมการแม็กซ์เวลล์จะเป็น ฟังก์ชันภายในช่องว่างและเวลา ถ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีต้นกำเนิดคลื่นเป็นแบบซายน์เวพ ซึ่งจะ พบมากในกระบวนการของไมโครเวฟ สมการที่ใช้ในการคำนวณจะอาศัยหลักการของกฎฟูเรียร์ มาช่วยวิเคราะห์ ดังสมการ

$$E(t) = \operatorname{Re}\left[E_{s}(r)e^{j\omega t}\right] = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\left[E_{s}e^{j\omega t} + \left(E_{s}e^{j\omega t}\right)^{*}\right]$$
(4.28)

$$H(t) = \operatorname{Re}\left[H_{s}(r)e^{j\omega t}\right] = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\left[H_{s}e^{j\omega t} + \left(H_{s}e^{j\omega t}\right)^{*}\right]$$
(4.29)

โดยที่

* หมายถึง ค่าบ่งบอกค่าเชิงซ้อน และตัวห้อย s บอกถึงรูปแบบของสถานะ ส่วนค่าสูงสุดของคลื่น หาได้จาก Peak = $\sqrt{2}$ rms ได้สมการ

$$j\omega\varepsilon E_s + \sigma E_s = \nabla \times H_s \tag{4.30}$$

$$-j\omega\mu H_s = \nabla \times E_s \tag{4.31}$$

เมื่อโยงความสัมพันธ์กับสมการที่ (4.26) และสมการที่ (4.27) ก็จะได้

$$\nabla^2 E_s = j\omega\mu\sigma E_s - \omega^2\mu\varepsilon E_s = \gamma^2 E_s \tag{4.32}$$

$$\nabla^2 H_s = j\omega\mu\sigma H_s - \omega^2\mu\epsilon H_s = \gamma^2 H_s \tag{4.33}$$

โดยที่

 $\gamma = \alpha + i\beta$ ค่าการกระจายตัวที่คงที่ α และ β เป็นค่าบ่งบอกถึงสถานะคงที่

เมื่อ α คือ ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน (Attenuation Coefficient) และ β คือ ค่าคงที่เฟส (Phase Constant)

ในการเปลี่ยนสถานะจะเกิดการแพร่กระจายของคลื่นซึ่งถูกกำหนดโดยตัวแปร β และตัว แปร α ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอัตราความเข้มข้นของสนาม และจะมีผลต่อการแทรกผ่านของคลื่นที่ ระดับความลึกที่ต่างกันจากบริเวณผิวหน้า ซึ่งค่าสถานะจะมีความสัมพันธ์กับก่าคุณสมบัติของวัสดุ ที่เป็นฉนวน ดังสมการ

$$\alpha = \omega \sqrt{\mu \varepsilon \left\{ \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2} - 1 \right] \right\}^{1/2}}$$
(4.34)

$$\beta = \omega \sqrt{\mu \varepsilon \left\{ \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2} + 1 \right] \right\}^{1/2}}$$
(4.35)

ใช้กฎของแอมแปร์ในความถี่เริ่มต้น $(\sigma_{\omega \varepsilon})^2$ จะมีสถานะแบบกลางๆ ถ้า $(\sigma_{\omega \varepsilon})^2 << 1$ ระยะ การนำความร้อนไม่ดี ถือว่าเป็นฉนวนที่ดี และถ้า $(\sigma_{\omega \varepsilon})^2 >>1$ ก็ถือว่าเป็นตัวนำความร้อนที่ดี

4.3 คลื่นระนาบ (Plane Waves)

หากมีการคาบเกี่ยว (Coupling) กันระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างโดย กระแสดิสเพลซเมนต์ (Displacement Current) สมการที่ (4.5) และการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก (Magnetic induction) สมการที่ (4.6) ส่งผลทำให้ได้สมการที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับการแพร่กระจายของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves) ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น หากทำการรวมสองสมการนี้เข้า ด้วยกัน แล้วทำการกำจัดค่าความเข้มสนามไฟฟ้า *H* เราก็จะได้สมการคลื่นเป็น

$$\nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times E - \omega^2 \varepsilon E = 0 \tag{4.36}$$

เหมือนกระบวนการเหมือนเดิม ถ้าต้องการกำจัดสนามไฟฟ้า E จากสมการที่ (4.5) และ สมการที่ (4.6) เพื่อให้แสดงเฉพาะแต่สนามแม่เหล็ก H หากพิจารณาในตัวกลางที่มีลักษณะเนื้อ เดียว หรือโฮโมจีเนียส เราสามารถใช้สมการที่ (4.8) เพื่อทำให้สมการที่ (4.36) อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นจะ ได้

$$\nabla^2 E + \omega^2 \varepsilon \mu E = 0 \tag{4.37}$$

เช่นเดียวกับกระบวนการเดิม สำหรับสนามแม่เหล็กก็จะได้

$$\nabla^2 H + \omega^2 \varepsilon \mu H = 0 \tag{4.38}$$

พิจารณาเฉพาะแกน z จากสมการที่ (4.37) จะได้

$$\frac{d^2 E_x}{dz^2} = -\omega^2 \varepsilon \mu E_x \tag{4.39}$$

โดยที่

 E_x คือสนามไฟฟ้าที่ขนานกับแกน x ดังนั้น คำตอบของสมการที่ (4.39) คือ

$$E_{x}(z) = Ae^{+\gamma z} + Be^{-\gamma z}$$
(4.40)

เมื่อ ค่าคงที่ A และ B สอดคล้องกับขนาดของคลื่นที่แพร่กระจาย (Propagating) ใน ทิศทาง –z และ +z ตามลำดับ โดย $\gamma = \omega \sqrt{\varepsilon \mu}$ เรียกว่าก่าคงที่ของการแพร่กระจาย (Propagation Constant) ซึ่งอยู่ในรูปจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งเขียนอยู่ในรูปทั่วไป คือ

$$\gamma = \alpha + j\beta$$
 Np/m (4.41)

โดยที่

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r \varepsilon_0 \varepsilon}{2}} \left[\sqrt{\sqrt{1 + \left(\frac{\varepsilon_{eff}}{\varepsilon}\right)^2}} - 1 \right] \qquad \text{Np/m}$$
(4.42)

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r \varepsilon_0 \varepsilon}{2}} \left[\sqrt{\sqrt{1 + \left(\frac{\varepsilon_{eff}}{\varepsilon}\right)^2} + 1} \right] \qquad \text{Np/m}$$
(4.43)

ซึ่งสมการที่ (4.34) และ (4.35) เทียบเท่ากับสมการที่ (4.42) และ (4.43) นั่นเอง

การเชื่อมต่อระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก บอกเป็นนัยๆว่าองค์ประกอบของ สนามไฟฟ้าของคลื่นที่กำลังแพร่กระจายที่แสดงในสมการที่ (4.40) จะสัมพันธ์กับองค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก ซึ่งรูปที่ 4.2 แสดงถึงการเดินทางของคลื่นระนาบที่มีองค์ประกอบของสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กที่เป็นไปตามกฎมือขวา เมื่อตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านในที่นี้พิจารณาเป็น วัสดุที่ดูดซับคลื่นหรือวัสดุที่คลื่นสูญเสียพลังงานได้ หรือเราเรียกว่าวัสดุลอสซี่ (Lossy Material) ซึ่งทำให้ขนาดของคลื่นค่อยๆลดลงแบบเอกซ์โพแนนเชียลตามระยะทาง

ต่อจากนี้ไป เราจะทำการวิเคราะห์หาค่าระยะความลึกเชิงผิว (Skin Depth, S) เมื่อคลื่น ระนาบเดินทางผ่านเข้าไปในวัสดุที่มีความยาวกึ่งอนันต์ พารามิเตอร์ตัวนี้มีความสำคัญมากในการ วิเคราะห์อันตรกิริยาระหว่างกลื่นไมโครเวฟและวัสดุไดอิเลกตริก

พิจารณาวัสดุกึ่งอนันต์ ที่ยาวตามแกน z จากระยะ z=0 ถึง z=∞ ดังนั้น ค่าคงที่ A ใน สมการที่ (40) จะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ เพื่อที่จะทำให้คำตอบยังคงมีค่าที่ขอบเขต z → ∞ หาก กำหนดให้ค่าคงที่ B = E₀ ซึ่งเป็นค่าความเข้มของสนามที่ผิววัสดุ เราสามารถหาสมการการ กระจายตัวของสนามภายในวัสดุที่หนากึ่งอนันต์ เป็น

$$E(z) = E_0 e^{-\varkappa} \tag{4.44}$$

เราสังเกตุเห็นว่าแอมพลิจูดของสนาม จะก่อยๆลดลงแบบเอกซ์ โพเนนเชียล (ดังรูปที่ 4.2) ตามแกน z ทั้งนี้

$$\left|E\right| = E_0 e^{-\alpha z} \tag{4.45}$$

พารามิเตอร์ α อธิบายถึงระยะที่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถแทรกผ่านเข้าภายในเนื้อ วัสดุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความถี่ที่ป้อนให้และสมบัติไดอิเลคตริกของวัสดุนั้นๆ ดังสมการที่ (4.42)



รูปที่ 4.2 การเดินทางของคลื่นภายในวัสดุไดอิเลคตริกหรือวัสดุลอสซึ่

ระยะความลึกเชิงผิว (Skin Depth) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงระยะที่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถ แทรกผ่านเข้าภายในวัสคุ ซึ่งนิยามอยู่ในรูปความลึกซึ่งขนาดของสนามมีค่าลดทอนลงเท่ากับ 1/e เท่าของสนามที่ผิววัสคุนั้น สำหรับคลื่นระนาบที่ตกกระทบบนวัสคุกึ่งอนันต์ โดยที่มีขนาดของ สนามที่ให้ไว้ในสมการที่ (4.45) ดังนั้นค่าระยะความลึกเชิงผิว แสดงได้ตามสมการดังต่อไปนี้

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \tag{4.46}$$

สำหรับวัสดุประเภทมีความสามารถในการดูคซับสูง (Very Lossy Material) จะมีค่าระยะ ความลึกเชิงผิวต่ำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะลคลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ความร้อนเกิดขึ้นที่บริเวณ ผิวเท่านั้น แต่สำหรับวัสดุประเภทมีความสามารถในการดูคซับต่ำ (Low Lossy Material) เช่น อาหารแช่แข็ง ค่าระยะความลึกเชิงผิว จะมีมากขึ้นทำให้สนามสามารถที่จะแทรกผ่านมากขึ้นตาม

สำหรับการให้ความร้อนจากไมโครเวฟในทางปฏิบัติ ค่าระยะความลึกเชิงกำลัง (Power Skin Depth; δ_p) มักจะถูกนำมาใช้เช่นกัน ซึ่งมีนิยามว่า ระยะความลึกที่กำลังการดูดซับ (Absorbed Power) ลดลงไปเท่ากับ 1/e เท่าของกำลังผิววัสดุนั้น และมีความสัมพันธ์กับกำลังการดูดซับที่เคย แสดงไว้ในสมการที่ (4.4) และเขียนได้ใหม่ในรูปดังนี้

$$Q = \frac{1}{2}\omega\varepsilon_0\varepsilon_{eff} \left| \hat{E}_0 \right|^2 e^{-2\alpha z} = Q_0 e^{-z/\delta_p}$$
(4.47)

โดยที่

 Q_0 คือ กำลังการดูดซับที่บริเวณผิว หรืออัตราความร้อนเชิงปริมาตรที่ผิว (z=0) δ_p คือระยะความลึกเชิงกำลัง (Power Skin Depth) ซึ่งแสดงได้ตามสมการ คังต่อไปนี้

$$\delta_p = \frac{1}{2\alpha} = \frac{\delta}{2} \tag{4.48}$$

สำหรับวัสดุที่ได้รับคลื่นระนาบ พบว่าประมาณ 63 เปอร์เซ็นต์ของกำลังถูกดูดซับที่ สถายตัวภายในระยะความลึกเชิงกำลัง และ 86 เปอร์เซ็นต์ภายในระยะความลึกเชิงผิว สำหรับวัสดุ จำพวกอาหาร โดยทั่วไป ไม่มีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็ก (μ_r = 1) ดังนั้นสมการที่ (4.42) สามารถจัดรูปให้ง่ายขึ้นและแทนค่าลงในสมการที่ (4.48) ก็จะได้ก่าระยะความลึกเชิงกำลัง

$$\delta_{p} = \frac{c}{\omega\sqrt{2\varepsilon'} \left(\sqrt{1 + \left(\varepsilon'/\varepsilon'\right)^{2}} - 1\right)^{1/2}}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_{0}\varepsilon_{0}}}$$

$$(4.49)$$

$$(4.50)$$

รูปที่ 4.3 แสดงการลดลงแบบเอกซ์ โพแนนเซียลของกำลังการดูดซับ สำหรับเนื้อที่อุณหภูมิ 0[°]C และ 25[°]C ตามลำคับ (ข้อมูลสมบัติสำหรับวัสดุแสดงในตารางที่ 2)

ເນື່ອ



รูปที่ 4.3 ระยะความลึกเชิงกำลังที่ 2.45 GHz สำหรับเนื้อที่อุณหภูมิ 0 $^{\circ}$ C และ 25 $^{\circ}$ C จะ ได้ δ_{p} =1.04 และ12.9 cm ตามลำดับ

วัสคุ	เปอร์มิตติวิตี้	ระยะความลึกเชิงผิว
เนื้อ (Beef)	40-j12	2.08 cm
เนื้อแช่แข็ง (Frozen Beef)	4-j0.3	26.0 cm
มะเขือเทศ (Mashed Potato)	65-j20	1.59 cm
แกรอท (Carrots)	41-j11	2.23 cm

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างก่าระยะกวามลึกเชิงผิวสำหรับวัสดุจำพวกอาหารชนิดต่างๆ ที่กวามถี่ 2.45 GHz.

หมายเหตุ ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าการคำนวณค่าระยะความลึกเชิงผิว จะถูกต้องเฉพาะวัสดุ ที่ได้รับคลื่นระนาบ และวัสดุที่มีความหนามากกว่าค่าระยะความลึกเชิงผิวหลายๆเท่า เท่านั้น ซึ่ง สามารถพิจารณาให้เป็นวัสดุกึ่งอนันต์ได้ สำหรับวัสดุที่มีความหนาน้อยกว่าค่าระยะความลึกเชิงผิว อิทชิพลของเรโซแนนท์ (Resonant) หรือการสั่นพ้องจะเกิดขึ้นภายในวัสดุ เป็นผลให้การกระจายตัว ของสนามไม่ลดลงแบบเอกซ์โพแนนเชียลจากพื้นผิว ในบางกรณีที่ความเข้มของสนามไฟฟ้ามีค่า สูงมากๆ กำลังการดูดซับจะปรากฏเฉพาะบริเวณกึ่งกลางของวัสดุเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการ สอดแทรก (Interference) ของคลื่นที่สะท้อนกลับจากบริเวณขอบด้านล่างของวัสดุ

4.4 ผลเฉลยของวัสดุที่มีขนาดจำกัด (Solution for a Finite Slab)

สำหรับวัสดุที่มีความหนาจำกัด (Finite Slab) ในการวิเคราะห์เชิงคำนวณจะต้องหาค่าคงที่ ทั้งสองที่ปรากฏในสมการที่ (4.40) ซึ่งในทางกายภาพต้องพิจารณาถึงการสะท้อนที่เกิดขึ้นจาก บริเวณขอบของวัสดุ รูปที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบของสนามที่ได้จากผลเฉลย 1 มิติของกรณีการ แก้สมการแม็กซ์เวลล์สำหรับวัสดุที่มีความหนาจำกัด กับกรณีที่สมมุติให้การลดลงของกำลังแบบ เอกซ์โพเนนเซียลสำหรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน [4] จะเห็นได้ชัดเจนว่า สำหรับวัสดุที่บางๆ สนามหรือค่ากำลังการดูดซับ (Power Absorbed) จะไม่ลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียลจากผิว แต่มี ลักษณะเป็นคาบคลื่น สำหรับวัสดุกอมโพซิท (Composite Slab) ซึ่งประกอบด้วยวัสดุไดอิเลคตริก มากกว่า 1 ชนิด ลักษณะการดูดซับพลังงานก็จะซับซ้อนมากขึ้น [5] (แสดงในรูปที่ 4.5)

คลื่นย้อนกลับในวัสดุบาง เป็นสาเหตุทำให้เกิดพฤติกรรมการแกว่งตัวของกำลังการดูดซับ มีลักษณะเป็นคาบคลื่น ด้วยพฤติกรรมอันนี้ มันเป็นไปได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงความหนาวัสดุเพียง เล็กน้อยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในปริมาณของพลังงานที่ดูดซับ นั่นก็หมายความว่าค่า หนึ่งเดียวของค่าระยะความลึกเชิงกำลังไม่สามารถพบได้ที่ความแน่นอนใดๆ Fu และ Metaxas [6] เสนอนิยามใหม่สำหรับหาค่าระยะกวามลึกเชิงกำลัง (Power Penetration Depth, Δ_p) ว่าระยะทางที่ พลังงานถูกดูดซับลดลงเป็น (1 - 1/e)ของพลังงานดูดซับทั้งหมด รูปที่ 6 แสดงค่าการแทรกผ่านเชิง กำลังในรูปตัวแปรไร้หน่วย ซึ่งเป็นฟังก์ชันของความหนาของวัสดุ สำหรับน้ำที่ อุณหภูมิ 20°C พบว่าเมื่อความหนาของวัสดุเพิ่มขึ้น ค่า Δ_p ก็จะเข้าใกล้ค่า δ_p ด้วยนิยามอันนี้ทำให้ยอมรับได้กับ การมีของค่าหนึ่งเดียวของ Δ_p ที่พบสำหรับที่ทุกๆความหนาของวัสดุ ซึ่งนิยามอันนี้ถือว่าเป็น ประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์ในกรณีที่มีการสมมติฐานให้กำลังการดูดซับลดลงของแบบ เอกซ์โพแนนเซียลภายในวัสดุ



รูปที่ 4 อิทธิพลของความหนาวัสดุต่อการกระจายตัวของกำลังการดูดซับกรณีวัสดุตัวอย่าง เป็นก้อนเนื้อดิบ (Raw Beef) ขณะที่ไมโครเวฟที่ความถี่ 2.45 GHz ป้อนมาจากทางฝั่งด้านซ้ายของวัสดุตัวอย่าง [1]

4.5 เงื่อนใบขอบเขต (Boundary Conditions)

ที่ตำแหน่งรอยต่อ (Interface) ของวัสดุสองชนิดที่มีคุณสมบัติใดอิเลคตริก คือ ค่าเปอร์มิตติ วิตี้ที่ต่างกัน (เช่น อากาศกับตัววัสดุเป็นต้น) สนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากจะไม่ต่อเนื่อง และใน ทำนองเดียวกันสำหรับสนามแม่เหล็กที่มีค่าเปอร์มีบิลิตี้ต่างกันตรงตำแหน่งรอยต่อ



รูปที่ 5 การกระจายตัวของสนามในวัสดุกอมโพซิท (Composite Slab) [1]



รูปที่ 6 ค่าระยะความลึกเชิงกำลัง (Power Penetration Depth, Δ_p) ที่เป็นฟังก์ชันกับความ หนาวัสดุที่ความถี่ 2.45 GHz สำหรับน้ำที่อุณหภูมิ 20[°]C [1]

เงื่อนไขขอบเขตที่บริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุสองชนิดเป็น ดังนี้

$$\varepsilon_1 E_1^n = \varepsilon_2 E_2^n \tag{4.51}$$

$$E_1^t = E_2^t \tag{4.52}$$

$$\mu_1 H_1^n = \mu_2 H_2^n \tag{4.53}$$

$$H_1^t = H_2^t \tag{4.54}$$

เมื่อ ตัวห้อย 1 และ 2 อ้างถึงวัสคุ 1 และ 2 ตามลำคับ ตัวยก n และ t แทนส่วนใน แนวตั้งฉากและแนวขนานกับพื้นผิว ตามลำคับ (คังรูปที่ 4.7) เงื่อนไขขอบเขตนี้เป็นสิ่งสำคัญใน การวิเคราะห์การให้ความร้อนจากไมโครเวฟ สนามไฟฟ้าที่ขนานกับพื้นผิวของวัสคุหรือโหลดจะ สร้างสนามขนาคใหญ่ คังนั้นความหนาแน่นของกำลังภายในวัสดุจะมีมากกว่ากรณีสนามไฟฟ้าใน แนวตั้งฉากกับพื้นผิวทั้งๆที่ความเข้มของสนามมีขนาดเท่าๆกัน



รูปที่ 4.7 เงื่อนไขขอบเขต

ผนังของแอพพลิเคเตอร์ถือว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือเรียกว่าเป็นตัวนำยิ่งยวด กรณีนี้ถือว่า
 ระดับการแทรกผ่านในโลหะก็น้อยมาก (≈µm) ดังนั้นวัสดุที่พิจารณาให้เป็นตัวนำยิ่งยวดจึงไม่มี
 สนามไฟฟ้าในแนวขนานกับพื้นผิวมันเอง นั่นคือองค์ประกอบของสนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส
 (Tangential) จึงมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเอง สิ่งเหล่านี้จึงมีผลกระทบกับการสะท้อนของคลื่นทั้งหมดที่
 ตกกระทบลงบนพื้นผิวนี้ เราจึงสามารถเขียนเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$E \times \hat{n} = 0 \tag{4.55}$$

โดยที่

n คือยูนิตเวกเตอร์ในแนวตั้งฉากกับพื้นผิว

เช่นเดียวกัน กรณีสนามแม่เหล็ก ก็จะไม่มีองค์ประกอบของสนามแม่เหล็กในแนวตั้งฉากกับพื้นผิว ดังนั้น

$$H \cdot \hat{n} = 0 \tag{4.56}$$

ในแอพลิเกเตอร์จริง ผนังจะไม่ใช่ตัวนำยิ่งยวคที่แท้จริง และต้องกำนวณหาก่าเหล่านี้โดยอาศัยวิธี เชิงตัวเลข (Numerical Solution) คังที่ได้ในงานวิจัยที่แสดงในเอกสารอ้างอิง [7]

4.6 การสะท้อน, การส่งผ่าน และการดูดซับ (Reflection, Transmission and Absorption)

เมื่อกลื่นระนาบเกลื่อนที่มาตกกระทบกับวัสดุ กลื่นหรือพลังงานส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับ และอีกส่วนหนึ่งจะส่งผ่านเข้าภายในวัสดุ ดังรูปที่ 8 สำหรับกลื่นระนาบที่สนามไฟฟ้าขนานกับ พื้นผิวและที่ตกกระทบทำมุม 0 กับแนวดิ่ง กลื่นที่ทะลุผ่านจะหักเหทำมุม 0 กับแนวดิ่ง ซึ่งอธิบาย ได้โดย กฎของสเนลล์ (Snell's law) ดังนี้



รูปที่ 4.8 คลื่นที่สะท้อนกลับและคลื่นที่ส่งผ่านบริเวณผิว

$$\sin\phi = \sqrt{\varepsilon_1}\sin\theta$$

(4.57)

ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน Г สำหรับสนามไฟฟ้าซึ่งอธิบายได้โดย กฎของเฟรสเนล (Fresnel's Laws) [2]

$$\Gamma = \frac{E_r}{E_i} = \sqrt{\varepsilon_2} \cos\theta - \sqrt{\varepsilon_1} \cos\phi \qquad (4.58)$$

สำหรับคลื่นที่ตกกระทบในแนวตั้งฉากกับผิววัสดุ($heta=0^{\circ}$) สามารถลดรูปได้เป็น

$$\Gamma = \sqrt{\varepsilon_2} - \sqrt{\varepsilon_1} \tag{4.59}$$

เนื่องจากกำลังมีค่าแปรผันตามกำลังสองของสนามไฟฟ้า คังนั้น สัคส่วนกำลังที่ส่งผ่านเข้าไปใน วัสคุ เท่ากับ

$$|T| = 1 - |\Gamma|^2 \tag{4.60}$$

สำหรับอาหารที่มีค่าเปอร์มิตติวิตี้ อยู่ในช่วงระหว่าง 40-60, จะมีค่า Γ ประมาณ 75% [8] (Tประมาณ 50%) พบว่าคลื่นส่งผ่านจะส่งสะท้อนเข้าไปภายในและสำหรับวัสคุบางรูปทรง อาจเกิด ปรากฏการณ์การอาร์คขึ้นได้ จากสมการที่ (4.60) ทำให้เราทราบถึงอัตราส่วนของกำลังส่งผ่านเข้า ไปภายในอาหาร ที่มาจากคลื่นระนาบเดี่ยว (Single Plane Wave) อย่างไรก็ตามตัวแอพพลิเกเตอร์ ในทางปฏิบัติ มักจะมีคลื่นในหลายระนาบที่มาจากหลายทิศที่มากระทบบนวัสดุ ซึ่งทำให้การ วิเคราะห์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จากสมการที่ (4.58) ที่มุมบางมุม ที่รู้จักกันว่า มุมบริวสเตอร์ (Brewster Angle) ซึ่งการสะท้อนจากผิวหน้ามีค่าเป็นศูนย์ นั่นหมายความว่าพลังงานทั้งหมดที่ตกกระทบจะถูกส่งผ่าน เข้าไปในวัสดุ องก์กวามรู้ที่ว่านี้ นำไปสู่การแนะนำที่ว่า ในการออกแบบแอพพลิเกเตอร์ของระบบ ไมโกรเวฟที่ดีกวรจะพิจารณาในส่วนนี้ด้วย

4.7 โหมดของการแพร่กระจายคลื่น (Modes of Propagation)

สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในวัสคุเนื้อเดียวหรือโฮโมจีเนียส สามารถหาคำตอบได้จาก สมการที่ (4.37) และ (4.38) ตามลำดับ ถ้าเราพิจารณาคำตอบของสมการเหล่านี้สำหรับคลื่น ตาม แนวแกน z เราจะพบคำตอบในรูป f(z)g(x, y) ที่ f เป็นฟังก์ชันของ z เพียงอย่างเดียวและ g เป็นฟังก์ชันของ x และ y [9] สิ่งนี้นำไปสู่การได้ซึ่งคำตอบมาตรฐานในลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ 4.7.1 ทรานสเวอร์สอิเลคตริกเวฟ (Transverse Electric Wave; TE) หรือเรียกว่าคลื่นที่มี แนวสนามไฟฟ้าวางตามขวาง ซึ่งสนาม H มีส่วนประกอบหรือเวกเตอร์ย่อยอยู่ในแกน X และ Z ของสนาม E หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีสนามไฟฟ้าในทิศของ การแพร่กระจายของคลื่นแต่มี เฉพาะสนามแม่เหล็กในทิศทางนั้น

$$E_z = 0, H_z \neq 0$$

4.7.2 ทรานสเวอร์สแมคเนตริกเวฟ (Transverse Magnetic Wave; TM) หรือเรียกว่าคลื่นที่
 มีแนวสนามแม่เหล็กวางตามขวาง ซึ่งสนาม E มีส่วนประกอบหรือเวกเตอร์ย่อยอยู่ในแกน X และ
 Y ของสนาม H หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีสนามแม่เหล็กในทิศของการแพร่กระจายของคลื่น
 แต่มีเฉพาะสนามไฟฟ้าในทิศทางนั้น

$H_z = 0, E_z \neq 0$

4.7.3 ทรานสเวอร์สอิเลคโตรแมคเนตริกเวฟ (Transverse Electromagnetic; TEM) หรือ เรียกว่าคลื่นที่มีแนวสนามไฟฟ้าแม่เหล็กวางตามขวาง ซึ่งไม่มีสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กในทิศ ของการแพร่กระจายของคลื่น

$$H_z = E_z = 0$$

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขขอบเขตในท่อนำคลื่นจะไม่อนุญาตให้เป็นลักษณะคลื่นโหมด TEM ทั้งนี้เพราะคลื่น TEM นั้น ไม่สามารถแพร่กระจายไปในท่อนำคลื่นซึ่งเป็นตัวกลางที่มีตัวนำเคียว สำหรับโหมดของการแพร่กระจายคลื่นในลักษณะปกติ เพื่อให้กำลังสามารถส่งผ่าน ได้ เราจึง พิจารณาให้เป็นคลื่นในโหมด TE₁₀ ในที่นี้ตัวห้อย หมายถึง จำนวนของครึ่งคลื่น (Semi Sinusoidal) ที่แปรเปลี่ยนในแนวแกน x และ y ตามลำคับ คลื่นในโหมด TE₁₀ มี หนึ่งครึ่งคลื่นที่แปรเปลี่ยนใน แนวแกน x และคงที่ในแนวแกน y

4.8 คาวิตี้ (Cavities)

โดยทั่วไป คาวิตี้สามารถแบ่งออกได้ สองประเภทคือ คาวิตี้ชนิดโหมดเดี่ยว (Single-Mode Cavities) และคาวิตี้ชนิดมัลติโหมด (Multimode Cavities) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

4.8.1 กาวิตี้ชนิดโหมดเดี่ยว (Single-Mode Cavities)

มีความเป็นไปได้ที่จะออกแบบแอพพลิเคเตอร์ ให้เป็นลักษณะเรโซแนนท์โหมคเดี่ยว (Single Resonant Mode) หรือเรโซแนนท์เดี่ยว (Single Resonance) ที่ทำงานใกล้เคียงกับความถึ่ ทำงาน ส่วนใหญ่แอพพลิเคเตอร์ลักษณะนี้จะเป็นรูปทรงกระบอก (Cylindrical Applicators) เป็น ชนิดโหมด TM₀₁₀ หรือทรงสี่เหลี่ยม (Rectangular Applicators) เป็นชนิดโหมด TE_{10n} ดังแสดงใน รูปที่ 9 ซึ่งลักษณะแอพพลิเคเตอร์แบบนี้ง่ายต่อการควบคุมการกระจายตัวของคลื่น และง่ายต่อการ วิเคราะห์ และออกแบบโดยวิธีคำนวณแบบง่ายๆ (Analytical Technique) [11] แอพพลิเคเตอร์ที่ กล่าวในที่นี้ มักใช้สำหรับกระบวนการทางอาหาร อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดอีกมาก เนื่องจาก เหตุผลที่ว่าปริมาตรของโหลดหรืออาหารที่ค่าไดอิเลกตริกใดๆ จะต้องมีขนาดเล็กๆเท่านั้น เพื่อที่ ยังกงสภาพกวามเป็นกลื่นเรโซแนนท์ภายในแอพพลิเกเตอร์อยู่ได้



รูปที่ 4.9 กาวิตี้ชนิดเร โซแนนท์โหมดเดี่ยว (a) โหมด TM₀₁₀ (b) โหมด TE_{10n}

4.8.2 คาวิดี้ชนิดมัลติโหมด (Multimode Cavities)

ส่วนใหญ่ในกระบวนการให้ความร้อนแก่อาหารจะใช้คาวิตี้ชนิดเรโซแนนท์มัลติโหมด (Multimode Resonant Cavity) ยกตัวอย่างเช่น เตาอบไมโครเวฟบ้าน ซึ่งภายในแอพพลิเคเตอร์มี โหลดติดตั้งอยู่ จะมีคลื่นไมโครเวฟซึ่งมาจากหลายระนาบและหลายทิศทางมาตกกระทบบนโหลด นี้ ผลรวมของคลื่นที่ตกกระทบนี้ร่วมกับคลื่นที่สะท้อนที่โหลดและผนังของแอพพลิเคเตอร์ ก่อให้เกิดคลื่นเรโซแนนท์ หรือ มัลติโหมด ทำให้การกระจายของสนามมีความซับซ้อนมากขึ้น การ วิเคราะห์และออกแบบโดยผ่านวิธีคำนวณแบบง่ายๆ ไม่สามารถกระทำได้ จึงต้องอาศัยเทคนิคการ คำนวณชั้นสูงและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เข้ามาช่วย นอกจากนี้ข้อสมมติฐานที่ว่า กำลังคลื่น ไมโครเวฟที่ลดลงแบบเอกซ์โพเนนเซียลภายในวัสดุนั้น พบว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้กับแอพพลิเค เตอร์ชนิด เรโซแนนท์มัลติโหมด อย่างไรก็ตามค่าระยะความลึกเชิงผิวยังพอนำมาใช้ในการ วิเคราะห์ได้ หากว่าวัสดุนั้นมีขนาดมากกว่าค่าระยะความลึกเชิงผิว (Skin Depth) มากๆ ไมโครเวฟ จะไม่สามารถแทรกผ่านไปยังส่วนกลางของวัสดุได้ ในกรณีนี้ความร้อนจะแพร่กระจายจากบริเวณ ผิวสู่ตำแหน่งที่ลึกลงไปโดยโหมดของการนำเป็นสำคัญ แต่ถ้าวัสดุมีความหนาน้อยกว่าระยะความ ลึกเชิงผิวแล้ว ไมโครเวฟจะสามารถแทรกผ่านไปยังส่วนกลางของวัสดุได้ ทำให้ความร้อนกระจาย ตัวสม่ำเสมอมากขึ้น แต่การกระจายตัวของคลื่นและความร้อนที่แท้จริงยังคงขึ้นกับปัจจัยอื่นอีก มากมาย และมีหลายเหตุผลที่ทำให้ความร้อนกระจายตัวไม่สม่ำเสมอได้

ภายในคาวิตี้ชนิดมัลติโหมด (Multimode Cavity) จะมีเรโซแนนท์หรือการสั่นพ้อง (Resonance) หลายตำแหน่ง อันเนื่องจากการสะท้อนของคลื่นจากผนังของคาวิตี้ทำให้เกิดรูปแบบ ของคลื่นนิ่งที่เสถียรภายในคาวิตี้ สำหรับกาวิตี้ที่ว่างเปล่าที่มีขนาด a × b × d ความถี่ของโหมดเร โซแนนท์ (Frequency of Resonant Modes) แสดงได้ดังสมการต่อไปนี้ [11]

$$\left(\frac{l\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{d}\right)^2 = \left(\frac{\omega_{lmn}}{c}\right)^2 \tag{61}$$

 $\{l, m, n\} = \{0, 1, 2, ...\}$

โดยที่ c คือ ความเร็วแสง (Speed of Light) ω_{lmn} คือ ความถึ่ของโหมดเรโซแนนท์ (Resonant Frequency of the Mode)

ตัวห้อย *l,m,n* คือจำนวนของครึ่งคลื่น (Number of Semi Sinusoidal) ในแนวแกน *x, y, z* ตามลำคับ เช่นเดียวกับโหมดการแพร่กระจายของคลื่นในท่อนำคลื่นดังที่ได้อธิบายข้างบน คาวิตี้ ชนิดมัลติโหมดสามารถแบ่งออกเป็นโหมด TE หรือ TM ในโหมดทั้งสองนี้จะมีตัวห้อยท้ายสามตัว คือ *l,m,n* หากทั้งหมดของ *l,m,n* ไม่เท่ากับศูนย์ ลักษณะของโหมดภายในคาวิตี้อาจเป็นได้ทั้ง TE และ TM [12] แต่ถ้า *l,m,n* ตัวใดตัวหนึ่งเท่ากับศูนย์ลักษณะของโหมดจะเป็น TE หรือ TM อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งคู่ ทั้งนี้จะต้องสัมพันธ์กับเงื่อนไขขอบเขตด้วย กรณีโหมดที่ตัวห้อย *l.m.n* มีค่าเป็นศนย์สองตัวหรือมากกว่า ก็ไม่สามารถสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตได้

การคำนวณแบบง่ายๆ โดยใช้สมการที่ (4.61) จะทำให้เราทราบจำนวนของโหมด ที่เกิดขึ้น ภายในคาวิตี้ที่ว่างในช่วงความถี่ที่กำหนด ตารางที่ 4.3 แสดงผลการคำนวณเพื่อให้ได้ค่าของโหมด ต่างๆ ภายในคาวิตี้ ที่ใกล้ค่าความถี่ 2.45 GHz และรูปที่ 4.10 แสดงขนาดของสนามสำหรับโหมดที่ ต่างกันสามโหมค ณ ระนาบบริเวณกึ่งกลางของคาวิตี้ สนามรวมภายในคาวิตี้ก็มาจากผลรวมของ คลื่นแต่ละโหมคนั่นเอง

ความถี่, GHz	l	m	n
2.4012	3	0	3
2.4186	4	1	2
2.4459	2	4	1
2.4602	3	1	3
2.4695	0	3	3
2.4808	0	4	2

ตารางที่ 4.3 โหมดเร โซแนนท์ ต่างๆ ภายในกาวิตี้ที่ว่างในช่วงกวามถี่ที่กำหนด [1]

การออกแบบกาวิตี้เพื่อให้มีจำนวนโหมดภายในกาวิตี้ที่ว่างให้มากเข้าไว้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะประการแรกหลายๆโหมดที่กำนวนได้จากสมการที่ (4.61) อาจไม่ได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ประการที่สอง เมื่อทำการใส่วัสดุหรือโหลดเข้าไปในกาวิตี้ ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของโหมด อีกทั้งหากวัสดุเป็นวัสดุลอสซี่หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติการดูดซับ ความเข้มของ การเกิดเรโซแนนท์หรือการสั่นพ้องที่แสดงไว้จากสมการที่ (4.61) ก็จะอ่อนลง ดังแสดงในรูปที่ 4.11 ด้วยเหตุนี้การกระจายตัวของสนามจะประกอบด้วยกลื่นหลายๆโหมดที่ซ้อนทับกัน ซึ่งส่งผล ต่อก่ากำลังการดูดซับ (Microwave Power Absorbed) ภายในวัสดุ

สำหรับแอพพลิเคเตอร์ในระบบไมโครเวฟนั้น จะมีคลื่นที่ไม่แพร่กระจายในบางโหมด โดยเฉพาะบริเวณตำแหน่งของการป้อนคลื่น (Feed Port) ซึ่งคลื่นที่ว่านี้อาจมีผลหรือไม่มีผลต่อค่า กำลังการดูดซับภายในโหลดก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของกาวิตี้หรือโหลดในระบบนั้นๆ



รูปที่ 4.10 ตัวอย่างรูปร่างของโหมดต่างๆ (a) l = 0, m = 3 (b) l = 4, m = 2 (c) l = 3, m = 1[1]



รูปที่ 4.11 การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ โหมคภายในแอพลิเกเตอร์ [1]

4.9 การวิเคราะห์แบบจำลองของแอพพลิเคเตอร์สำหรับระบบไมโครเวฟ

สมการในรูปแบบง่ายๆที่ให้ไว้ในหัวข้อที่ผ่านมาที่ใช้อธิบายถึงโหมดของคลื่นภายในคาวิตี้ ชนิดมัลติโหมด ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลเพียงกร่าวๆ เท่านั้นว่าเกิดอะไรขึ้นภายในกาวิตี้นี้ ที่ผ่านมามี นักวิจัยหลายกนพยายามเสนอแบบจำลองและวิธีหากำตอบสำหรับปัญหาที่กาบเกี่ยวกันระหว่าง แบบจำลองของกลื่นไมโกรเวฟและแบบจำลองของสนามกวามร้อน สำหรับกระบวนการทำกวาม ร้อนด้วยไมโกรเวฟ

เป็นที่ทราบกันดีว่าสำหรับในกรณีคาวิตี้ชนิดโหมดเดี่ยวนั้นการวิเกราะห์เรื่องสนามทำได้ ง่ายเพียงใช้สมการในรูปแบบง่ายๆ [1] แต่สำหรับคาวิตี้ชนิดเรโซแนนท์มัลติโหมดนั้นมีความ ซับซ้อนกว่ากันมากโดยเฉพาะรูปทรงเชิงเรขาคณิตของทั้ง ตัวโหลด ตัวกาวิตี้และสนามกลื่นเอง เพื่อลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์ในรายงานวิจัยส่วนใหญ่จึงมักพิจารณารูปทรงเชิงเรขาคณิตให้ เป็นลักษณะง่ายๆ เช่นพิจารณาให้ตัวคาวิตี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม รวมทั้งโหลดที่ติดตั้งภายในคาวิตี้นี้ก็ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นกัน [1] แม้ว่าผลของคำตอบที่ได้เป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงในทางปฏิบัตินัก

แม้ว่าผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Solution) จากแบบจำลองแบบง่ายๆ จะยังไม่สะท้อน ถึงปัญหาที่แท้จริงในทางปฏิบัตินัก อย่างไรก็ตาม พารามิเตอร์หรือตัวแปรบางตัวที่เป็นพื้นฐานที่มี อิทธิพลต่อระบบสามารถวิเคราะห์ได้งาย ในทางตรงกันข้าม ผลเฉลยที่ได้จากระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) สามารถที่จะใช้อธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนในแบบจำลอง แบบที่ซับซ้อนได้ และได้กำตอบที่สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงในทางปฏิบัติ

4.10 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ปัญหาการให้ทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ

หากพิจารณาการได้มาซึ่งแบบจำลองความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กโดย ผ่านสมการแม็กซ์เวลล์ ทำให้เรามองต่อไปได้ว่าเราสามารถสร้างแบบจำลองของการทำความร้อน โดยไมโครเวฟได้เช่นกัน ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงแบบจำลองดังกล่าวซึ่งแบ่งออกเป็น สองกรณีดังนี้

- การออกแบบไมโครเวฟบ้าน (Domestic Oven Design)

- การออกแบบไมโครเวฟอุตสาหกรรม (Industrial Oven Design)

4.10.1 การออกแบบไมโครเวฟบ้าน (Domestic Oven Design)

เตาไมโครเวฟบ้านมีการประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับกระบวนการทำความร้อน ในเชิงการพัฒนา ได้ทำการเพิ่มระบบเข้าไปเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ ว่าจะเป็นการเพิ่มระบบการหมุน (Turntable) การติดตั้งใบกวน (Mode Stirrer) และการปรับปรุง ระบบการป้อนคลื่นไมโครเวฟ (Feed System) ให้ดีขึ้นโดย การรวมผลของสิ่งเหล่านี้ทำให้ช่วยเพื่อ การกระจายตัวที่ดีของคลื่น และการกระจายตัวที่ดีของความร้อนภายในโหลด อย่างไรก็ตามการ ออกแบบรูปทรงพื้นฐานของเตาไมโครเวฟก็ยังคงเป็นสี่เหลี่ยมและมีป้อนคลื่นทางเดียวโดยไม่ เปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์เตาไมโครเวฟหลากหลายที่ได้รับการออกแบบ แต่ก็สามารถ ทำงานได้ดีที่สุดในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งเท่านั้น ยังคงต้องพัฒนาต่อเพื่อสามารถนำไป ประยุกต์ใช้งานในสถานภาพที่หลากหลายมากขึ้น

ใด้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจำลองระบบ เพื่อทำให้การออกแบบระบบที่ เหมาะสมขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควร ถึงแม้ว่ามีรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับการ จำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับเตาไมโกรเวฟบ้าน [18, 20, 21, 24, 42, 44, 46, 47] แต่งานวิจัยเหล่านี้ยังคงจำกัดอยู่กับระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟขนาดเล็กเมื่อเทียบกับระบบ เชิงอุตสาหกรรม นอกจากนี้งานวิจัยส่วนใหญ่ยังเน้นการวิเคราะห์โดยอาศัยแบบจำลองเพียงอย่าง เดียว ยังขาดข้อมูลวิจัยเชิงทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากผลของแบบจำลอง ในอนาคต การ ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขรูปแบบใหม่ๆเพื่อใช้จำลองและวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งการออกแบบ จะ เป็นทางเลือกใหม่ของศาสตร์ด้านนี้ โดยประเด็นที่สำคัญสำหรับการออกแบบระบบทำความร้อน ด้วยไมโครเวฟที่ควรต้องพิจารณามีดังนี้

การออกแบบตำแหน่งการป้อนไมโครเวฟ จะมีผลอย่างมากต่อการกระจายตัวของ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในตู้ไมโครเวฟ การจำลองโดยคอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Simulation) สามารถใช้ศึกษาถึงผลของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการป้อนไมโครเวฟภายใต้สภาวะ ทดสอบต่างๆ ผลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการออกแบบเพื่อให้ได้ระบบที่ดีที่สุด โดยที่ลดจำนวนการสร้างเครื่องต้นแบบจริง (Prototypes) เพื่อเป็นการประหยัดก่าใช้จ่าย [46, 47]

สำหรับเตาไมโกรเวฟบ้านนั้น โดยทั่วไปในการผลิตจะยอมให้มีค่าพิกัคเผื่อ (Tolerances) ในระดับหนึ่ง นั่นหมายถึงจะมีความแตกต่างของรูปแบบความร้อนเล็กน้อยหากมีการใช้เตา ไมโกรเวฟคนละตัวแม้จะเป็นโมเคลเคียวกัน การจำลองโดยคอมพิวเตอร์ช่วย สามารถใช้ศึกษา ผลกระทบของสิ่งที่กล่าวมานี้ได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของขนาคตัวเตา [48]

การใช้ระบบการหมุน (Turntable) หรือใบกวน (Mode Stirrer) ภายในเตาไมโครเวฟ ส่งผล ทำให้การจำลองโดยคอมพิวเตอร์เป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากต้องคำนึงถึงผลของการ เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามเวลาที่ผ่านไป ซึ่งส่งผลโดยตรงกับ การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวเตา อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเพียงเล็กน้อยที่รายงานถึง ปัญหาที่กล่าวนี้ เนื่องจากความซับซ้อนของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์รวมทั้งขีดความสามารถใน การกำนวณของคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องที่มีความเร็วสูง

4.10.2 การออกแบบไมโครเวฟอุตสาหกรรม (Industrial Oven Design)

เตาไมโครเวฟระดับอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในกระบวนการละลายผลิตภัณฑ์แช่แข็งและ กระบวนการพาสเจอไรซ์สำหรับการฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งในการออกแบบต้องพึ่งพาการจำลอง โดยคอมพิวเตอร์ช่วย เตาไมโครเวฟระดับอุตสาหกรรมนี้มักจะออกแบบให้สอดคล้องกับความ ต้องการของสายการผลิต และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของโหลด เช่นกันเนื่องจาก ถ่าใช้จ่ายในการออกแบบเพื่อให้ได้ระบบที่ดีที่สุดสำหรับเชิงอุตสาหกรรมจะแพงกว่าการออกแบบ เตาไมโครเวฟบ้านมาก ดังนั้นการทดสอบหลักการพื้นฐาน แล้วจึงมาขยายสเกลขึ้นไปเป็นระบบ ขนาดใหญ่ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะลดขั้นตอนการสร้างระบบนำร่อง โดยมุ่งเป้าสร้างระบบขนาด ใหญ่เลย โดยเฉพาะเมื่อทำการสร้างระบบที่เป็นคาวิตี้ ชนิดมัลติโหมด การจำลองโดยคอมพิวเตอร์ ช่วยสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ นอกจากนี้การจำลองโดย คอมพิวเตอร์ช่วยยังเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับพิสูจน์กฎพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และยังใช้ สนับสนุนประกอบการทำการยื่นคำของคสิทธิบัตรเมื่อมีการออกแบบระบบใหม่ๆ [10]

ความยุ่งยากหลักของการออกแบบเตาไมโครเวฟในเชิงอุตสาหกรรมคือ ขนาดเชิงกายภาพ ของระบบ ในระบบขนาดใหญ่ หากทำการวิเคราะห์โดยผ่านการจำลองโดยคอมพิวเตอร์ช่วยจะด้อง มีจำนวนกริดหรือเอลิเมนต์จำนวนมากเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูลการคำนวณจาก แบบจำลอง นั่นหมายความว่าจะต้องใช้ทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการคำนวณดังกล่าว ผล เฉลยจากแบบจำลองโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับคาวิตี้ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมที่เคยรายงานผ่าน บทความวิจัยตีพิมพ์ มักจะสมมุติให้โดเมนที่ใช้วิเคราะห์มีลักษณะสมมาตร (Symmetry) หรือมี รูปแบบเฉพาะ เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ นอกจากนี้มีการนำคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Supercomputer) มาช่วยในการคำนวณเพื่อประหยัดเวลา [50] โดยปกติในการคำนวณเราจะไม่ กำหนดให้มีจำนวนกริดที่น้อยเกินไป หรือใช้กริดที่หยาบ (Coarse Grid) เพราะส่งผลต่อความ แม่นยำของการคำนวณ [51]

สิ่งที่ยุ่งยากอีกประการก็คือ ในกรณีการวิเคราะห์ระบบเชิงอุตสาหกรรม ที่ในการออกแบบ จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบต่อเนื่อง (Continuous Process) ที่มีผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ผ่านคาวิตี้หรือเตา โดยการลำเลียงของสายพาน นั่นหมายกวามว่าการจำลองโดยกอมพิวเตอร์ช่วยกับระบบที่ผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลา จะต้องใช้วิธีหรือเทคนิกพิเศษเข้ามาช่วยเพื่อกวามถูกต้องของกำตอบ

4.11 สรุป

กล่าวได้ว่าการเข้าใจอย่างสมบูรณ์ของอันตรกิริยาของไมโครเวฟกับวัสดุไดอิเลคตริกใน ระหว่างกระบวนการทำความร้อนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี ไมโครเวฟในการทำความร้อน ในบทนี้เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีการสร้างแบบจำลองแบบต่างๆ รวมทั้งพื้นฐานการออกแบบระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ ในลักษณะต่างๆ

รายการสัญลักษณ์

с	ความเร็วแสง (Speed of Light, 3×10 ⁸) m/s
В	ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density)
D	ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า (Electric Flux Density) C/m ²
Ε	ความเข้มสนามไฟฟ้า (Electric Field Strength) V/m
f	ความถี่ (Frequency) Hz
Н	ความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Strength) A/m

115

\hat{i},\hat{j},\hat{k}	เวกเตอร์ระบบพิกัคฉาก (Cartesian Unit Vector)
j	$\sqrt{-1}$
J	ความหนาแน่นกระแส (Current Density) A/m ²
\boldsymbol{J}_{t}	ความหนาแน่นกระแสรวม (Total Current Density) A/m ²
n	เวกเตอร์ตั้งฉากพื้นผิว (Normal Vector to a Surface)
q	ความหนาแน่นประจุไฟฟ้า (Charge Density)
Q	ความหนาแน่นกำลัง (Power Density) W/m ²
t	เวลา (Time)
V	ความต่างศักย์ไฟฟ้า (Voltage)

สัญลักษณ์ภาษากรีก

α	ค่าคงที่การลดทอน (Attenuation Constant) Np/m
β	ค่าคงที่เฟส (Phase Constant) Np/m
γ	ค่าคงที่การแพร่กระจาย (Propagation Constant)
Е	คุณสมบัติไดอิเลคตริก (Permittivity, ${f E}={f E}_0{f E}_r$) F/m
ε	ค่าคงที่ใดอิเลคตริกสัมพัทธ์ (Relative Dielectric Constant)
$\mathcal{E}^{"}$	ค่าคงที่การสูญเสียสัมพัทธ์ (Relative Dipolar Loss Factor)
$\mathcal{E}^{''}_{e\!f\!f}$	ค่าประสิทธิพลการสูญเสียสัมพัทธ์ (Relative Effective Loss Factor)
${\cal E}_0$	ค่าเปอร์มิตตีวิตี้ในที่ว่าง (Permittivity of Free Space, 8.854×10 ⁻¹²) F/m
\mathcal{E}_r	คุณสมบัติไดอิเลคตริกสัมพัทธ์ (Relative Permittivity, $\varepsilon_r = \varepsilon - j \varepsilon_{eff}$)
Γ	ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน (Reflection Coefficient)
μ	ค่าการซึมผ่าน (Permeability, $\mu=\mu_0\mu_r$) H/m
μ_0	ค่าการซึมผ่านในที่ว่าง (Permeability of Free Space, 4 $\pi imes 10^{-7}$) H/m
μ_r	ค่าการซึมผ่านสัมพัทธ์ (Relative Permeability)
σ	ค่าการนำไฟฟ้า (Electric Conductivity) S/m
ω	ความถี่เชิงมุม (Angular Frequency) rad/s
δ	ค่าระยะความลึกเชิงผิว (Skin Depth) m
${\delta}_{_p}$	ระยะความลึกเชิงกำลัง (Penetration Depth) m

 Δ_p ค่าระยะความลึกเชิงกำลัง

เอกสารอ้างอิง

- Datta, K. and Ramaswamy C. Anantheswaran. Electromagnetics: "Fundamental Aspects and Numerical Modeling." Handbook of Microwave Technology for Food Applications .Marcel Dekker, Inc. New York. Basel, 1-31, (2001).
- [2] Arthur Von Hippel. "Dielectrics and Waves." Wiley, New York, (1954).
- [3] Metaxas, A.C., "Foundations of Electro Heat." A Unified Approach. John Wiley and Sons Ltd., Chichester, UK, (1996).
- [4] Ayappa, K.G., Davis, H.T., Crapiste, G., Davis, E.A., and Gordon, J. "Microwave Heating: An Evaluation of Power Formulations." Chemical Engineering Science, 46(4), 1005-1016, (1991).
- [5] Ayappa, K.G., Davis, H.T., Davis, E.A., and Gordon, J., "Analysis of Materials with Temperature Dependent Properties." AIChE Journal, 37(3), 313-322, (1991).
- [6] Fu, W., and Metaxas, A.C., "A Mathematical Derivation of Power Penetration dpth for Thin Lossy Materials." Journal Microwave Power and Electromagnetic Energy, 27(4), 217-222, (1992).
- [7] Ehlers, R.A., Dibben, D.C., and Metaxas, A.C., "The Effect of Wall Losses in the Numerical Simulation of Microwave Heating Problems". Submitted to Journal Microwave Power and Electromagnetic Energy. (1999).
- [8] Rismam, P.O., and Ohlsson, T., "2450 mHz Microwave Heating Distributions in Food Material Slabs and Cylinders." In KEMA 26-29 Sept. Arnhem, The Netherlands, (1989).
- [9] Collin, R.E., "Foundations for Microwave Engineering". McGraw-Hill, New York, (1992).
- [10] Bows, J.R., Patrick, M.L., Dibben, D.C., and Metaxas, A.C., "Computer Simulation and Experimental Validation of Phase Controlled Microwave Heating. In Microwave and High Frequency Heating". Fermo, Italy, 23-26, (1997).
- [11] Metaxas, A.C., and Meredith, R.J., "Industrial Microwave Heating". Number 4 in IEE Power Engineering Series. Peter Peregrinus Ltd., London, (1983).
- [12] Turner, R.F.B., Voss, W.A.G., Tinga, W.R., And Baltes, H.P., "On the Counting of Modes in Rectangular Cavities". Journal Microwave Power and Electromagnetic Energy, 19(3),199-208, (1984).

- [13] Ppaoloni, F., "Calculation of Power Deposition in a Highly Over Mode Rectangular Cavity with Dielectric Loss". Journal Microwave Power and Electromagnetic Energy, 24(1),21-32, (1989).
- [14] Lorenson, C., and Gallerneault, C., "Numerical Methods for the Modeling of Microwave fields". In D.E. Clark, F.D. Gac, and W.H. Sutton, Eds., Symposium on Microwaves: Theory and Application in Materials Processing, American Ceremic Society, 193-200, (1991).
- [15] Silvester, P., and Ferrar, R., "Finite Elements for Electrical Engineers". Cambridge University Press, Cambridge, UK, 3rd ed., (1997).
- [16] Yee, K.S., "Numerical Solution of Initial Boundary Value Problem Involving Maxwell's Equations in Isotropic Media". IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 14, 302-307, (1966).
- [17] Taflove, A., Review of the Formulation and Applications of the Finite Difference Time Domain Method for Numerical Modeling of Electromagnetic Wave Interactions with Arbitrary Structure. Wave Motion, 10, 547-582, (1988).
- [18] Desai, R.A., Lowery, A.J., Christopolos, C., Naylor, P., Blanshard, J.M.V., and Gregson,
 K., "Computer Modeling of Microwave Cooking Using the Transmissionline Model". IEE
 Proceedings A, 139(1), 30-38, (1992).
- [19] Sundberg, M., "Moment method and FDTD Analysis of Industrial Microwave Ovens. In Microwave and High Frequency Heating, Fermo, Italy, 19-22, (1997).
- [20] Lui, F., Turner, I., and Bialkowski, M., "A Finite Difference Time Domain Simulation of Power Density Distribution in a Dielectric Loaded Microwave Cavity". Journal Microwave Power and Electromagnetic Energy, 29(3),138-148, (1994).
- [21] Lizhuan, M., Dominique-Lynda Paul, Nick Pothecary, Chris Railton, John Bows, Lawrence Barratt, Jim Mullin, and David Simons. "Experimental Validation of a Combined Electromagnetic and Thermal FDTD Model of a Microwave Heating Process". IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, 43(11), 2565-2572, (1995).
- [22] Sundberg, M, Risman, P., Kildal, P.S., and Ohlson, T., "Analysis and Design of Industrial Microwave Ovens Using the Finite Difference Time Domain method." Journal Microwave Power and Electromagnetic Energy, 31(3), 142-157, (1996).
- [23] Richard Holland. "Pitfalls of Staircase Meshing". IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 35(4), 434-439, (1993).

- [24] Iwabuchi, K., Tetsuo Kubota, Tatsuya Kashiwa, and Hiroaki Tagashira. "Analysis of Electromagnetic Fields Using the Finite Difference Time Ddomain Method in a Microwave Oven Loaded with High Loss Dielectric". Electronics and Communications in Japan, 78(7), 41-50, Translated from Denshi Joho Tsushin Gakkai Ronbunshi, 78-C-I (2), (1995).
- [25] Krishnaiah, K.M., and Railton, C.J., "A Stable Subgridding Algorlithm and its Application to Eigen Value Problems". IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, 47(5), 620-628, May (1999).
- [26] Railton, C.J., and Schneider, J.B., "An Analytical and Numerical Analysis of Several Locally Conformal Feted Schemes". IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, 47(1) 56-66, January (1999).
- [27] Dey, S., and Mittra, R., "A Conformal Finite Difference Time Domain Technique for Modeling Cylindrical Dielectric Resonators". IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 47(9), 1737-1739, September (1999).
- [28] Zhao, H., and Turner, I.W., "An Analysis of the Finite Difference Time Domain Method for Modeling Microwave Heating of Dielectric Materials within a Three Dimensional Cavity System". In Scientific and Industrial RF and Microwave Applications Conference, Melbourne, Australia, 9-10 Jul, (1996).
- [29] BOSSAVIT, A., "Solving Maxwell Equation in a Closed Cavity, and the Question of Spurious Modes." IEEE Transactions on Magnetic, 26(2), 702-705, (1990).
- [30] Bossavit, A., "Computational Electromagnetism: Variational Formulations, Complementarity, Edge Elements". Academic Press, San Diego, (1998).
- [31] Dibben, D., "Numerical and Experimental Modeling of Microwave Applicators." PhD thesis, Cambridge University, (1995).
- [32] Dibben, D., and Metaxas, A.C., "Frequency Domain vs. Time Domain Finite Element methods for Calculation of Fields in Multimode Cavities". IEEE Transactions on Magnetics, 32(2), 1468-1471, (1997).
- [33] Bossavit, A., "Uniqueness of Solution of Maxwell Equations in the Loaded Microwave Oven, and How it May Fail to Hold. In Microwave and High Frequency Heating". Cambridge, England, (1995).
- [34] Dibben, D., and Metaxas, A.C., "Time Domain Finite Element analysis of Multimode microwave Applicators." IEEE Transactions on Magnetics, 32(3):942-945, (1996).

- [35] Dibben, D., and Metaxas, A.C., "Finite Element Time Domain Analysis of Multimode Applicators Using Edge Elements". Journal Microwave Power and Electromagnetic Energy, 29(4), 242-251, (1994).
- [36] Hano, M., and Itoh, T., "Three-dimensional Time-domain Method for Solving Maxwell's Equations Based in Circumcenters of Elements". IEEE Transactions on Magnetics, 32(3), 946-949, (1996).
- [37] Iskander, M.F., Smith, R.L., Andrade, A.O.M., Kimrey, H., and Walsh, L.M., "FDTD Simulation of Microwave Sintering of Ceramics in Multimode Cavities." IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, 42(5), 793-800, (1994).
- [38] Iwabuchi, I., Tetsuo Kubota, Tatsuya Kashiwa, and Hiroahi Tagashira. "Analysis of Electromagnetic Fields in a Waveguide Feed Microwave Oven by FD-TD Method". In Japanese Electronic, Information and Communication Society Spring Meeting, 2, 546, (1994).
- [39] Sundberg, M., "Quantification of Heating Uniformity in Multi-applicator Tunnel Ovens. In Microwave and High Frequency Heating". St John's College Cambridge, England, September 17-21, (1995).
- [40] Hugo, M., and Metaxas, A.C., "Domain Decomposition with Electromagnetic Finite Element Analysis." In Microwave and High Frequency Heating, Fermo, Italy, 27-30, (1997).
- [41] Hugo, M., and Metaxas, A.C., "Domain Decomposition and Parallel Processing in Microwave Applicator design". In 11th International Conference on Domain Decomposition Methods, Greenwich, UK, 537-542, (1999).
- [42] David, D., and Metaxas, A.C., "Finite Element Analysis of Multimode Cavities with Coupled Electrical and Thermal Fields". In 29th IMPI Microwave Power Symposium, Chicago. 25-27 July, (1994).
- [43] Ralf, H., "Multigrid Method for maxwell's equations". SIAM Journal of Numerical Analysis, 36(1), 204-225, (1999).
- [44] Seung, W.L., Hong,B.L., Hyun,K.J., Song-yop Hahn, PanSeok Shin, Changyul Cheon, and Jong-Chull Shon. "3D Analysis of a Microwave Oven Using Vector Finite Element Methods". In CEFC, Okayama, Japan, (1996).
- [45] Adriano, P., and Vadim, V. Y., "Modeling and Industry: A time to Cross". Microwave World, 20(2), 14-19, September (1999).

- [46] Akira, A., and Takashi, K., "Electromagnetic Wave a Analysis in Developing Microwave ovens." Technical Report, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., February 41 (1), (1995).
- [47] Koji, I., Tetsuo, K., and Kashiwa, T., "Analysis of Electromagnetic Fields in a Mass-Produced Microwave Oven Using Finite Difference Time Domain Method". Journal Microwave Power and Electromagnetic Energy, 31(3), 188-196, (1997).
- [48] Gaetano, B., Samanta, B., Paolo, B., and Gabriela, F., "Sensitivity of FD-TD Simulations to Small Mesh Modifications in Microwave Oven Designs". In Microwave and High Frequency Heating, Fermo, Italy, 60-63, (1997).
- [49] Magnus, S., "Simulation of Sterilization and Pasteurization in Multimode Applicators". In 29th IMPI Microwave Power Symposium, Chicago. July 25-27, (1994).
- [50] Bellanca, G., Golfieri, G., Basssi, P., and Falciasecca, G., "Evaluation of Dissipated Power in Microwave Dielectric Ovens by FD-TD". In Microwave and High Frequency Heating, Cambridge, England, (1995).
- [51] Burfoot, D., Railton, C.J., Foster, A.M., and Reavell, S.R., "Modelling the Pasteurisation of Prepared Meals with Microwaves at 896 MHz". Journal of Food Engineering, 30, 117-133, (1996).
- [52] Richadd, M., Keefer and Mel D. Ball. "Improving the Final Quality of Microwave Foods". Microwave World, 13(2), 14-21, (1992).
- [53] Harry, A.R., and Aaron L. Brody. Visions, "Realities and Myths About Packaging for Heating Food in microwave Ovens". In 28th IMPI Microwave Power Symposium, Montreal. July 11-14, (1993).
- [54] Jin, J.M., Volakis, J.L., Yu, C.L., and Woo, A.C., "Modeling of Resistive Sheets in Finite Element Solution". IEEE Transactions an Antennas and Propagation, 40(6), 727-731, June (1992).
- [55] Ratanadecho, P., "Microwave Heating Using a Rectangular Wave Guide", Ph.D Thesis, Nagaoka University of Technology, Japan, (2002).